

## ГЕДЕОН МОВСЕСОВИЧ АВАКЬЯНЦ

12 апреля 1969 года исполнилось 50 лет со дня рождения члена-корреспондента Академии наук Армянской ССР, доктора физико-математических наук, профессора Гедео́на Мовсесовича Авакья́нца.

Г. М. Авакья́нц родился в г. Самарканде. В 1942 г. окончил физико-математический факультет Средне-Азиатского (ныне Ташкентского) государственного университета. По 1946 г. работал в физико-технической лаборатории АН УзССР (ныне Физико-технический институт).

В 1950 г. Г. М. Авакья́нц после окончания аспирантуры под научным руководством выдающегося советского физика академика И. Е. Тамма защищает кандидатскую диссертацию на тему „Спектр и угловое распределение фотонов, генерируемых быстрыми электронами в тонких пластинках“.

После защиты диссертации Г. М. Авакья́нц работает в ФТИ АН УзССР. Диапазон его научных интересов широк — Г. М. Авакья́нц работает в областях ядерной физики, эмиссионной электроники, физики полупроводников и полупроводниковых приборов. С 1956 по 1965 г., наряду с работой в ФТИ УзССР, Г. М. Авакья́нц занимает должность заведующего кафедрой теоретической физики в ТашГУ.

По инициативе Г. М. Авакья́нца в ТашГУ была организована проблемная лаборатория полупроводников и новая специализация — „Физика полупроводников“.

В 1958 г. в Москве (ФИАН) Г. М. Авакья́нц защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, посвященную обобщению теории полупроводников на случай отличия температуры носителей тока в полупроводниках от температуры решетки. В основу анализа явлений положена идея о „горячем“ электро́не. Была развита теория явлений переноса тепла и электричества в полупроводниках в условиях больших полей и токов, приводящих к разогреву носителей тока, изменению законов взаимодействия носителей с решеткой, росту электропроводности за счет ударной ионизации и т. д. Впервые последовательно были рассмотрены явления переноса в неравновесных условиях в приповерхностной области полупроводника, развиты теории примесной фото-э.д.с. и высокочастот.



ного транзистора с шириной базы, сравнимой с длиной свободного пробега, выдвинуто и обосновано предположение об аномальной зависимости подвижности от сильного электрического поля в условиях перекрытия зон.

Работы Г. М. Авакьянца снискали ему известность и получили высокую оценку научной общественности.

В марте 1965 г. Г. М. Авакьянц был избран членом-корреспондентом АН Армянской ССР и переехал на работу в Армению. В настоящее время он заведует отделом электроники Института радиофизики и электроники АН АрмССР и кафедрой физики полупроводников и диэлектриков Ереванского государственного университета.

Г. М. Авакьянцом опубликовано вместе соавторами 120 научных работ и монография „Феноменологическая теория полупроводников“, получены 2 авторских свидетельства.

Под его редакцией выпущен сборник трудов I Всесоюзного совещания по физике  $p-n$ -переходов, организация которого была поручена Г. М. Авакьянцу.

Свою научную работу Г. М. Авакьянц всегда сочетал с педагогической, отдавал много сил воспитанию высококвалифицированных научных кадров. Им подготовлено 11 кандидатов наук, еще трое завершают работу над диссертацией.

Гедеон Мовсесович полон сил и творческой энергии. Пожелаем ему новых больших творческих достижений и крепкого здоровья.